

в том числе	
время рассасывания	3 мкс
время спада	1 мкс
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ	2 МГц
Тепловое сопротивление переход — корпус	0,35 °С/Вт
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,97

Предельно допустимые значения параметров транзисторов

Максимально допустимый импульсный ток коллектора ($t_p < 10$ мс, скважность 2, $I_b = 0,20 I_k$ - для классов 0,5...2, $I_b = 0,25 I_k$ - для классов 2,5...6)

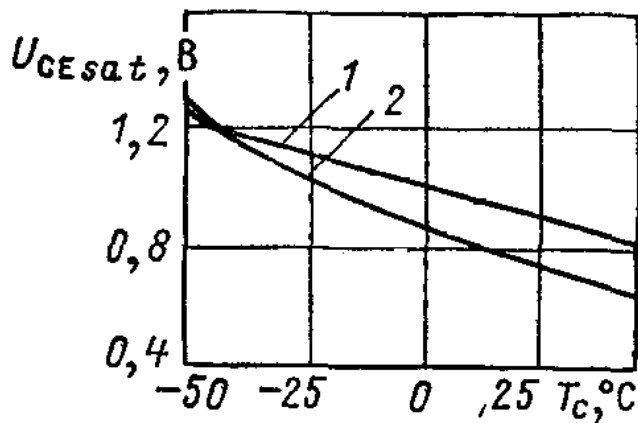
ТК152-80	80 А
ТК152-100	100 А
Максимально допустимый импульсный ток базы ($t_p < 10$ мс, скважность 2)	
ТК152-80	20 А
ТК152-100	25 А
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	
ТК152-80	50 А
ТК152-100	63 А
Максимально допустимый постоянный ток базы	
ТК152-80	16 А
ТК152-100	20 А
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база	50...600 В
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер	30...360 В
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер	45...540 В
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор — эмиттер	45...540 В
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база	
для классов 0,5...2	4 В
для классов 2,5...6	6 В
Температура перехода	-60...+150°С
Температура хранения	-60...+50°С
Рассеиваемая мощность коллектора	350 Вт

По максимально допустимому импульсному напряжению коллектор-база транзисторы делятся на восемь классов, а по напряжению насыщения коллектор — эмиттер — на три группы.

Класс	Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор — база, В
0,5	50
1,0	100
1,5	150
2,0	200
2,5	250
3,0	300
3,5	350
4,0	400
5,0	500
6,0	600
7,0	700
8,0	800

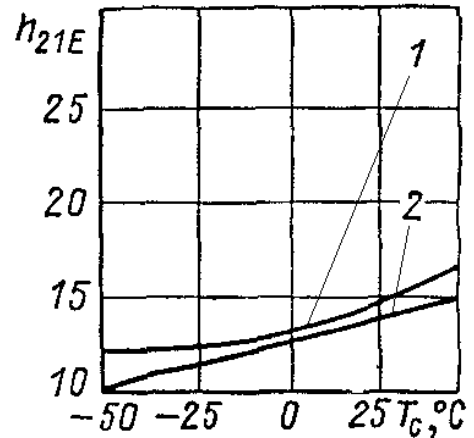
Группа по напряжению насыщения коллектор — эмиттер	Значение напряжения насыщения, В
1	До 0,6
2	Св. 0,6 до 1
3	Св. 1 до 1,5

Зависимость напряжения насыщения коллектор - эмиттер от температуры корпуса на постоянном токе



(1) – TK152-80; (2) TK152-100

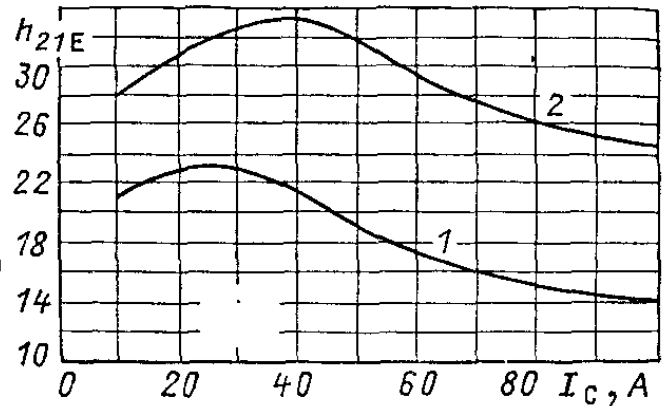
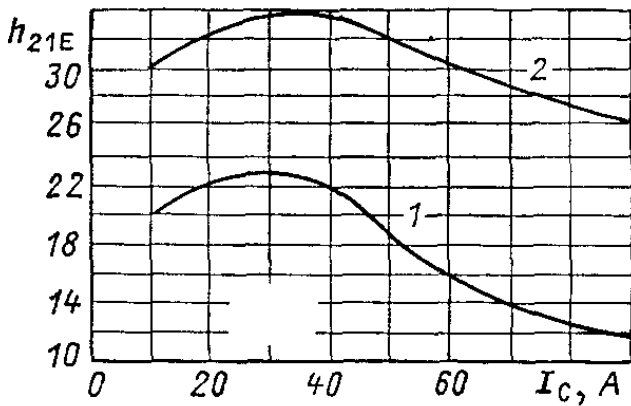
Зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса на постоянном токе



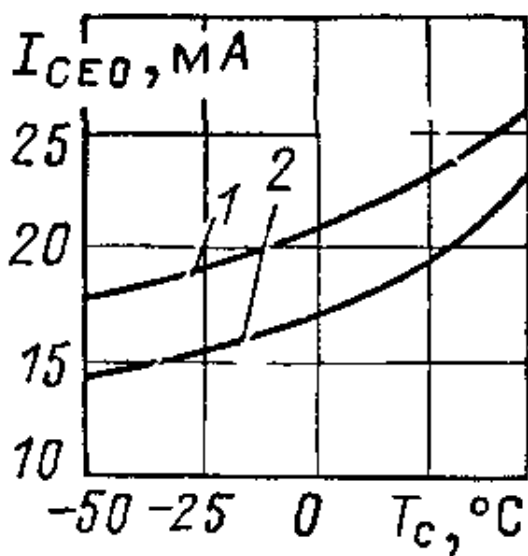
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора при $U_{кэ} = 5$ В, $T_{пер} = 25^{\circ}C$ (1) и $T_{пер} = T_{пер.макс}$ (2)

TK152-80

TK152-100

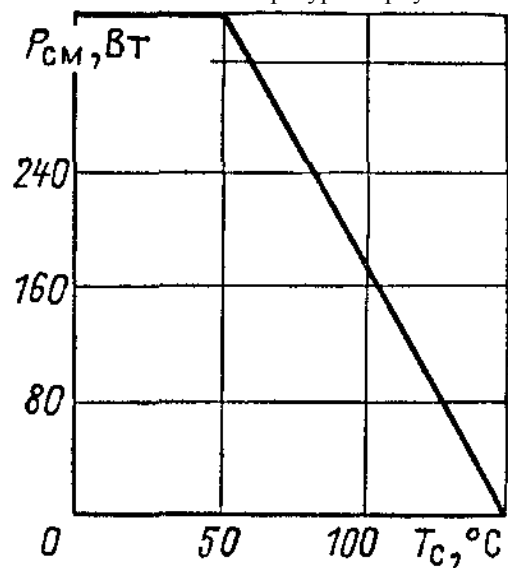


Зависимости обратного тока коллектор-эмиттер от температуры корпуса при $I_b = 0$

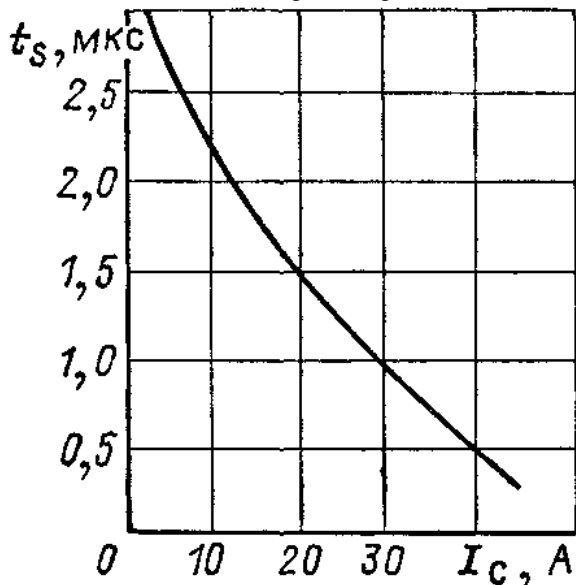


(1) – TK152-80; (2) TK152-100

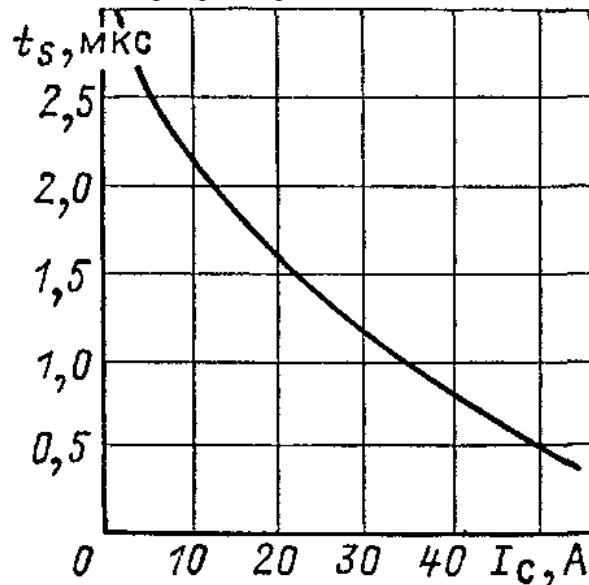
Зависимости рассеиваемой мощности от температуры корпуса



Зависимости времени рассасывания от тока коллектора при $T_{пер} = 25^\circ\text{C}$, $I_k/I_6 = 5$

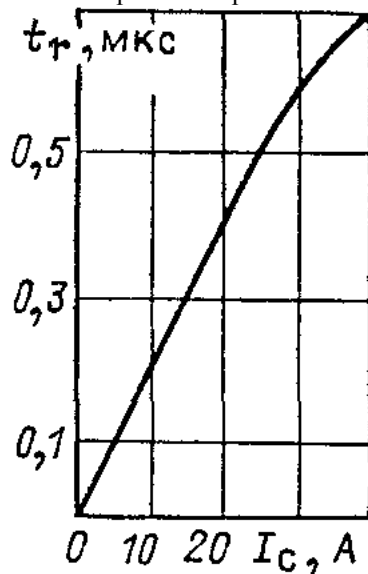


TK152-80

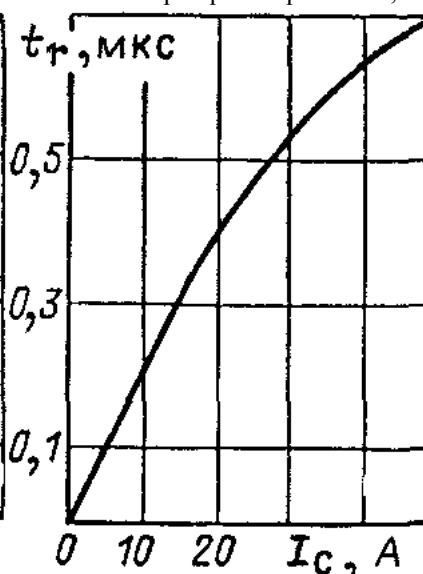


TK152-100

Зависимости времени нарастания от тока коллектора при $T_{пер} = 25^\circ\text{C}$, $I_k/I_6 = 5$

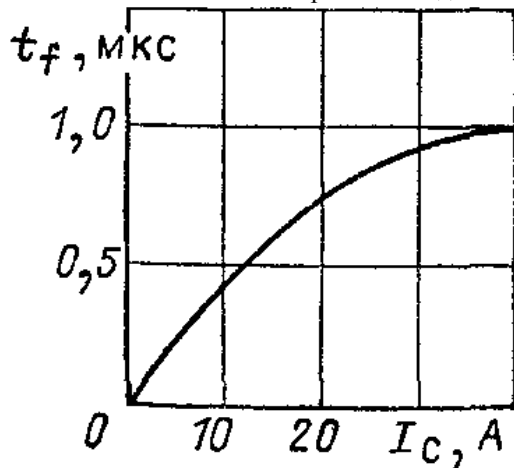


TK152-80

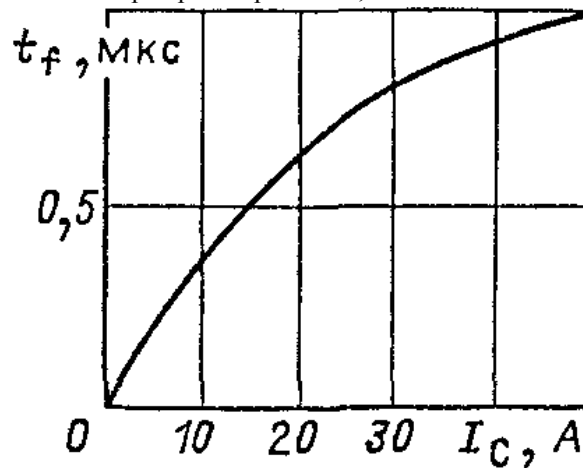


TK152-100

Зависимости времени спада от тока коллектора при $T_{пер} = 25^\circ\text{C}$, $I_k/I_6 = 5$

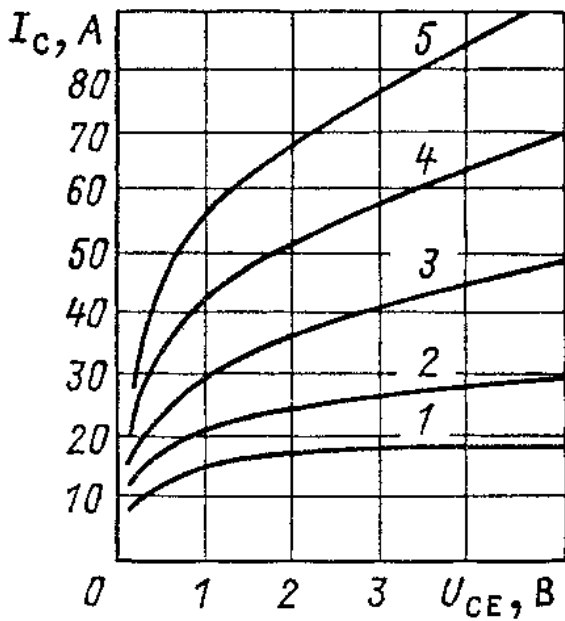


TK152-80

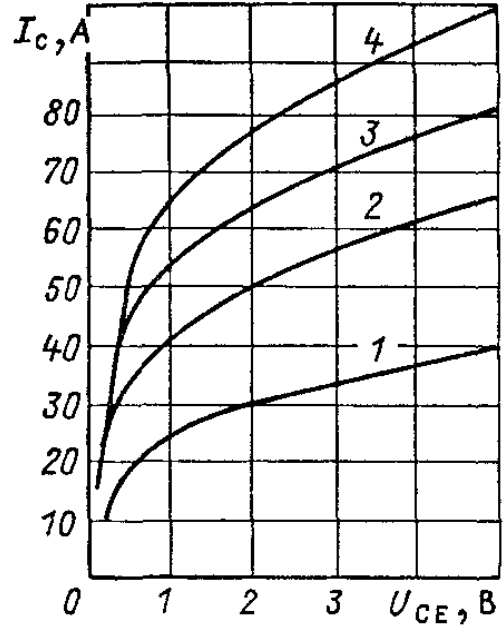


TK152-100

Выходные характеристики в импульсном режиме при $T_{пер} = 25^{\circ}\text{C}$



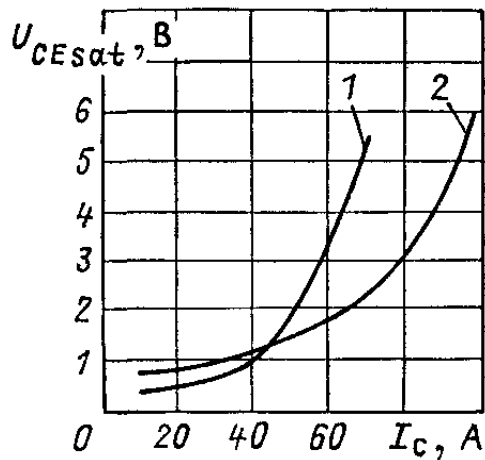
TK152-80



TK152-100

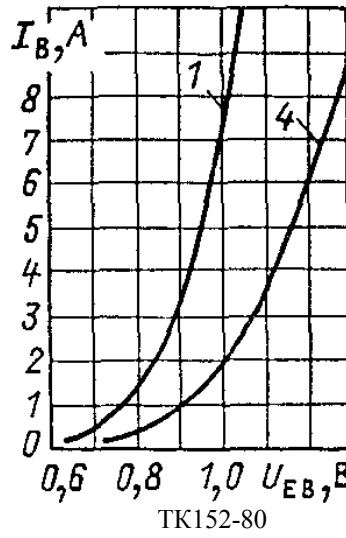
(1) $I_B = 0,04 I_{К}$; (2) $I_B = 0,06 I_{К}$; (3) $I_B = 0,1 I_{К}$; (4) $I_B = 0,2 I_{К}$; (5) $I_B = 0,25 I_{К}$

Зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора при $T_{пер} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{К}/I_B = 5$

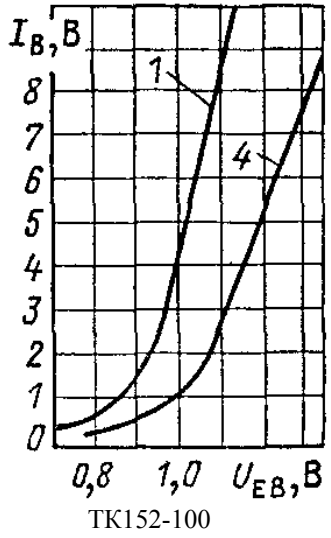


(1) – TK152-80; (2) TK152-100

Входные характеристики при $U_{КЭ} = 0$ (1); $U_{КЭ} = 4$ В (4)



TK152-80



TK152-100

Типовая область изменения напряжения коллектор-эмиттер в зависимости от сопротивления в цепи база-эмиттер при $T_{пер} = 150^{\circ}\text{C}$

